《電子學與電路學》

今年考題重點電路學著重於開關及簡單直流電器,皆屬傳統題目,而電子學則著重於 BJT 小信號 AC 分析,波形產生器及 FET DC 偏壓分析。

第一題:考生須會簡單一階直流開關電路基本解析觀念。

試題評析

第二題:頗爲簡單之直流電路分析(並非直流網路)。

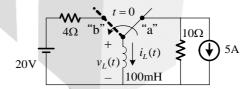
第三題:BJT 完整分析,包括直流偏壓分析及交流小信號 AC 分析。

第四題:方波/三角波產生器,考生須了解比較器及電容非線性充放電方程式之解析,方有能力求

解振盪頻率。

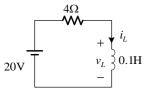
第五題: 甚爲簡單之基本 FET 直流偏壓電路分析。

- 一、如圖所示電路,開關於 t < 0 時已置於位置"a"很久且已達穩定,在 t = 0 時將開關理想切換至位置"b",請求出:
 - (一)當t≥0之電感電流公式i_L(t)=?(5分)
 - (二)在 $t=0^+$ 之電感電壓初始值 $v_1(0^+)=?(5分)$
 - (三)當電感電壓值達到 $v_L(t_1) = 20V$ 時之 $t_1 = ? (5分)$
 - (四)當電感電壓值達到 $v_L(t_2) = v_L(0^+) \cdot e^{-l}V$ 時之 $t_2 = ? (5 分)$



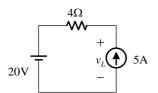
【擬答】

(-)當 $t = 0^-$ 時,可得:



$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0^+) - i_L(\infty)]e^{-\frac{R}{L}t} = 5 + (-5 - 5)e^{-\frac{4}{0.1}t} = (5 - 10e^{-40t})A$$

(二)當 $t = 0^+$ 時,可得:



$$v_L(0^+) = (5 \times 4) + 20 = 40A$$

$$(\stackrel{\frown}{=}) v_L(t) = 0.1 \frac{di_L(t)}{dt} = 0.1 \frac{d}{dt} (5 - 10e^{-40t}) = 40e^{-40t}V$$

1

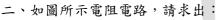
$$\Rightarrow$$
 20 = 40e^{-40t₁}

$$\Rightarrow t_1 = \left(\frac{1}{40} \ln 2\right) S \doteqdot 0.0173S$$

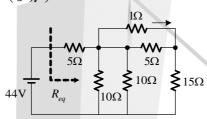
$$(\square) v_{L}(t_{2}) = v_{L}(0^{+})e^{-1}$$

$$\Rightarrow 40e^{-40t_2} = 40e^{-1}$$

$$\Rightarrow t_2 = \frac{1}{40}S$$



- (一)等效電阻R_{eq} = ? (10分)
- (二)流經 1Ω電阻之電流I=?(5分)
- (三)在 15Ω電阻上之消耗功率=? (5分)



【擬答】

$$(--)R_{eq} = 5 + \left[\frac{5}{6} \right] \left[\frac{44}{5} \Omega$$

$$\begin{array}{c|c} (\Box) & I_1 & 5\Omega & I_2 & W \\ \hline & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & & \\$$

$$I_1 = \frac{44}{44} = 5A$$

$$I_2 = \frac{5}{5 + \left(15 + \frac{5}{6}\right)}I_1 = \frac{6}{5}A$$

$$I = \frac{5}{1+5}I_2 = 1A$$

$$(\Xi) P_{15\Omega} = I_2^2 \times 15 = \left(\frac{6}{5}\right)^2 \times 15 = \frac{108}{5} W$$

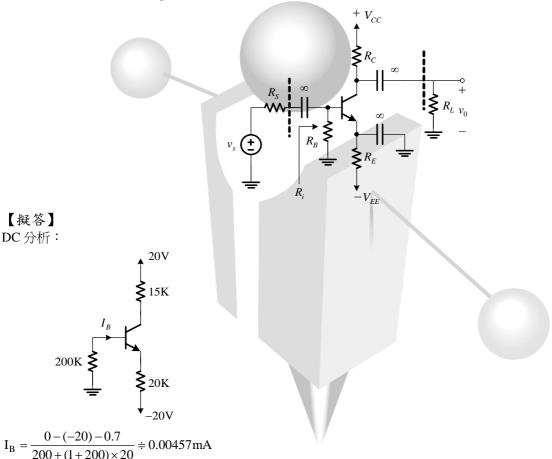
三、如圖所示電路,已知 $R_B=200k\Omega$, $R_E=20k\Omega$, $R_C=15k\Omega$, $V_{CC}=V_{EE}=20V$,電晶體 BJT 之 $\beta=200$, $V_{BE}=0.7V$,熱電壓(thermal voltage) $V_T=25mV$,忽略歐利效應(Early Effect) $\gamma_0=\infty$,



 $R_S = 20kΩ$, $R_L = 20kΩ$,請求出在小訊號模型下:

(-)從 R_s 往右側看入之輸入電阻 $R_i = ? (5分)$

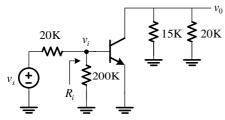
(二)電壓增益
$$A_v = \frac{v_0}{v_0} = ?$$
 (15 分)



$$I_{B} = \frac{0 - (-20) - 0.7}{200 + (1 + 200) \times 20} = 0.00457 \text{ mA}$$

$$\gamma_{\pi} = \frac{v_T}{I_B} = \frac{25mA}{0.00457mA} \doteqdot 5.47k\Omega$$

(一) AC 分析:



$$R_i = 200 \text{K} // 5.47 \text{K} = 5.324 \text{k}\Omega$$

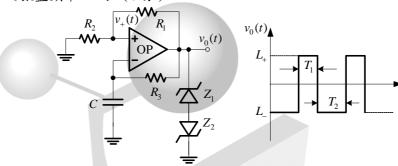
$$(\stackrel{\frown}{-}) A_v = \frac{v_0}{v_s} = \frac{v_0}{v_i} \times \frac{v_i}{v_s} = \frac{-200(15/\!/\,20)}{5.47} \times \frac{R_i}{20 + R_i} \doteqdot 65.89$$

四、如圖所示振盪電路之OP為理想運算放大器,已知稽納二極體之崩潰電壓為 $V_{Z1}=15V$, $V_{Z2}=10V$, 導通電壓 $V_D=0V$, $C=0.025\mu F$, $R_1=R_2=400k\Omega$, $R_3=800k\Omega$,請求出:



2010 高點檢事官電資組·全套詳解

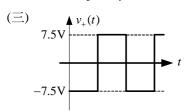
- (-)輸出電壓 v_0 之最大值 $L_+ = ? (5分)$
- (二)輸出電壓 v_0 之最小值 $L_=$? (5分)
- (三)繪出 OP "+" 輸入端之波形圖 $v_+(t)$,同時標示出最大及最小值。(5分)
- (四)輸出波形之振盪頻率f=?(5分)



【擬答】

$$(--)L_{+} = v_{Z_{1}} + v_{D_{2}} = 15 + 0 = 15V$$

$$(\stackrel{\frown}{_}) L_{-} = -(v_{Z_2} + v_{D_1}) = -(15 + 0) = -15V$$



$$v_{+}(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_0(t) = \frac{1}{2} v_0(t)$$

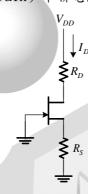
(四)
$$T = 2R_3C \ln \left(\frac{1+\beta}{1-\beta}\right)$$
 , $\beta = \frac{R_2}{R_2 + R_1} = \frac{1}{2}$

$$= 2 \times 800 \times 10^{3} \times 0.025 \times 10^{-6} \, \ell n \left(\frac{1 + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} \right) S = 4.394 \times 10^{-2} S$$

1

2010 高點檢事官電資組·全套詳解

- 五、如圖所示電路 V_{DD} = 15V,工作點電流 I_D = 8mA,已知 n-通道 JFET 之夾止電壓(pinch-off voltage) V_P = -3V , I_{DSS} = 18mA ,JFET 於飽和區工作時之電流公式為 I_D = $k\cdot(V_{GS}-V_P)^2$,其中 k 為常數,請求出:
 - (一)JFET 源極端 (Source) 之串聯電阻 R_s = ? (10 分)
 - (二)JFET工作於飽和區之最大汲極端(Drain)串聯電阻R_D=?(10分)



【擬答】

$$(\longrightarrow) 8 = 18 \left(1 - \frac{V_{GS}}{-3}\right)^2 \Rightarrow V_{GS} = -1V$$

得:
$$V_{GS} + I_D \cdot R_S = 0 \Rightarrow -1 + (8 \times R_S) = 0 \Rightarrow R_S = \frac{1}{8} k\Omega$$

$$(\stackrel{\frown}{}) V_D = 15 - 8 \times R_D$$

工作在飽和區條件爲:

$$V_{GS} \leq V_{P}$$

$$\Rightarrow 0 - (15 - 8R_D) \le 3 \Rightarrow R_D \le \frac{12}{8} = \frac{3}{2}k\Omega$$

得:
$$R_{D(max)} = \frac{3}{2} k\Omega$$